

PBlaze5 910/916 系列 NVMe™ SSD

高性能 SSD，为数据中心业务加速

Memblaze 推出的 PBlaze5 910/916 系列固态硬盘，采用 64 层 3D NAND，容量高达 15.36TB。凭借卓越稳定的性能，大幅度优化的典型工作功耗，为现代数据中心提供高速、绿色访问解决方案。

PBlaze5 910/916 关键指标

- 采用 64 层 3D eTLC NAND，提供高达 15.36TB 用户容量
- 读带宽高达 6GB/s，读性能高达 100 万 IOPS
- 30%~40% 的能效比提升
- 平均无故障时间 2 百万小时
- 精确到每瓦的功耗控制
- TRIM 速度高达 8TB/s
- 支持 32 个命名空间
- 支持双端口

应用和负载

- 数据库
- 流媒体
- 云和大规模计算
- 高性能软件定义存储
- 搜索，检索和内容分发
- 深度挖掘和大数据分析
- 高性能存储系统
- ERP 系统, SAP HANA 系统
- 业务支撑系统，银行系统，财税系统
- 高频交易系统，在线支付系统

64 层 3D NAND 实现更高密度，更低成本

PBlaze5 910/916 采用领先的 64 层 3D NAND，最高可提供 15.36TB 单盘超大存储容量，相比采用 32 层 3D NAND 的 PBlaze5 700 11TB 旗舰单品，实现单设备 40% 的容量提升，进一步提高机架存储密度，减少机架数量，节省空间。充分满足近些年云计算互联网、金融、电信、人工智能等行业对海量数据快速访问的需求。

30%~40% 的能效比提升，打造绿色数据中心

PBlaze5 910/916 系列高性能 NVMe SSD，提供高达 6GB/s 读带宽和 100 万 IOPS 读性能，基于策略的优先级调度保证读写混合工作负载下 QoS 要求。PBlaze5 910/916 系列在延续出色一致性能的同时，功耗大幅降低，相比同一代 PBlaze5 700/900 系列能效比提高 38%，为数据中心提供更加高效节能的存储产品(能效比 = 性能 / 功耗，即每消耗一瓦功耗可以提供的性能)。

能效比 = 性能 / 功耗，即每消耗一瓦功耗可以提供的性能

数据安全可靠保证

PBlaze5 910/916 系列延续了产品在安全性和可靠性方面的设计积累和方法验证，LDPC 纠错、AES256 自加密、全路径数据保护、增强掉电保护技术，为企业用户的业务保驾护航。

灵活精确的功耗控制

PBlaze5 910/916 系列支持 16 档功耗模式设置，从 10W 到 25W，每档功耗间切换时间在 1ms 以内，为企业级用户和存储系统提供精确动态的功耗控制。

高达 8TB/s 的企业级 TRIM 功能

为了满足云计算场景对安全性和性能的双高要求，PBlaze5 910/916 系列支持企业级 TRIM 功能，保证云计算环境下多用户访问的数据安全性，同时降低写放大，提升业务性能，提高 SSD 使用寿命。TRIM 速度高达 8TB/s，对业务影响极小，方便用户灵活选择 TRIM 时间。

支持 32 个多命名空间

PBlaze5 910/916 支持最高创建 32 个命名空间，助力多业务混部场景，共享单设备容量和性能，提高资源利用率。结合系统端 IO 控制软件，根据不同业务需求，对不同命名空间进行 QoS 管理。

双端口高可用

PBlaze5 910/916 系列支持双端口功能，两个端口可以同时访问，解决了单路径失效的问题，保证数据访问的连续性。



PBlaze5 910/916 系列 NVMe™ SSD

高性能 SSD，为数据中心业务加速

注释：

[1] 性能会因操作系统和固件版本不同而存在差异。

[2] 测试在设备稳态下进行，使用 SNIA SSS-PTS-E 测试规范。

[3] 平均延迟使用 4KB 随机 I/O 模型。

[4] DWPD，5 年每天全盘写入次数。

PBlaze5 910/916 规格 ^[1]	D910			C910			D916			C916		
可用容量 (TB)	3.84	7.68	15.36	3.84	7.68	15.36	3.2	6.4	12.8	3.2	6.4	12.8
接口	PCIe 3.0 x 4			PCIe 3.0 x 8			PCIe 3.0 x 4			PCIe 3.0 x 8		
外形	2.5 寸 U.2			HHHL			2.5 寸 U.2			HHHL		
读带宽 (128KB)(GB/s)	3.5	3.5	3.5	5.6	6.0	5.3	3.5	3.5	3.5	5.6	6.0	5.3
写带宽 (128KB) (GB/s)	3.2	3.5	3.5	3.2	3.5	3.5	3.2	3.5	3.5	3.2	3.5	3.5
随机读 (4KB) IOPS	835K	835K	835K	850K	1000K	970K	835K	835K	835K	850K	1000K	970K
随机写 (4KB) IOPS (稳态) ^[2]	100K	135K	150K	100K	135K	150K	210K	300K	300K	210K	300K	300K
延时 读取 / 写入 ^[3]	87 / 12 μs						88 / 11 μs					
寿命 ^[4]	1 DWPD						3 DWPD					
不可修复错误率 (UBER)	< 10 ⁻¹⁷											
平均无故障时间 (MTBF)	200 万小时											
协议标准	NVMe 1.2a											
闪存类型	3D eTLC NAND											
支持操作系统	RHEL, SLES, CentOS, Ubuntu, Windows Server, VMware ESXi											
功耗	7~25 W											
基本功能	增强掉电数据保护、热插拔、全路径数据保护、S.M.A.R.T、灵活功耗管理											
高级功能	TRIM、多命名空间、AES256 自加密、快速启动、密钥删除、双端口											
软件支持	NVMe Cli、Smartctl 等开源管理工具、原生驱动支持											
认证	美国: FCC 欧洲: CE, RoHS, WEEE, REACH 中国: BSMI											



请浏览网站获取更多信息：
www.memblaze.com

咨询热线：
400-650-7995

咨询邮箱：
contact@memblaze.com

版权所有 2019 北京忆恒创源科技有限公司保留一切权利。本文所含信息可能随时修改，恕不另行通知。